# 太陽電池裏面レーザーポイントコンタクトの最適化 Optimization of Laser Transferred Contact Process for c-Si Solar Cells 東工大院理工<sup>1</sup>

○卜部駿介,Ateto Eric Omondi,宮島晋介 Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Tech. °Shunsuke Urabe, Ateto Eric Omondi, Shinsuke Miyajima

E-mail: urabe.s.ac@m.titech.ac.jp

### 【はじめに】

高効率結晶シリコン太陽電池構造として、PERC 構造が知られている。我々は、ワイドギャップへテロエミッタと PERC 構造を組み合わせ (Fig.1)、変換効率 19.8% ( $V_{oc}$ =0.677 V、 $J_{sc}$ =39.9 mA/cm², FF=0.733)を実現してきた。更なる高効率化には、コンタクト部の品質向上による  $V_{oc}$  改善が必要である。本報告では、コンタクト部形成プロセスの最適化を報告する。

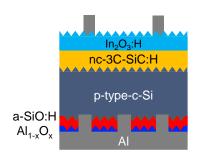


Fig.1 Structure of fabricated PERC solar cell

# 【研究手法】

p型 Si 基板に ALD(Atomic Layer Deposition) 法により  $Al_2O_3$  を成膜した。また、ガラス基板に真空蒸着 Al を成膜した。その後,Si 基板とガラス基板を重ね,レーザーを照射し,ポイントコンタクトを形成した。レーザー照射部の構造は,レーザー顕微鏡および TEM(Transmission Electron Microscope)を用いて観察した。また, $V_{oc}$  の指標となる少数キャリアライフタイムと Implied- $V_{oc}$  は,QSSPC(Quasi Steady State Photo Conductance)を用いて評価した。

## 【実験結果】

ガラス基板上の AI 膜厚がポイントコンタクト形成に与える影響を検討した。Fig.2 はレーザー照射部の光学顕微鏡像である。AI 膜厚の増加に伴い、コンタクト幅が減少した。これは AI を厚膜化することで、コンタクトを形成するために必要なレーザーパワーが増加したためと考えられる。またライフタイムを測定した結果、比較的 AI 膜厚の薄い 500~1000 nm においては 200~300  $\mu$ s 程度の値が得られた。さらに AI 膜厚を増加させると、ライフタイムは増加し、最大で 733  $\mu$ s(Implied- $V_{\infty}$ は 695 mV)という値が得られた。以上の結果から、更なる最適化により 700 mV を超える高い  $V_{\infty}$ を実現可能と考えられる。

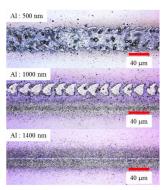


Fig.2 The laser microscope image of laser point contact

#### 【謝辞】

本研究の一部は、NEDO から委託され実施された。関係各位に感謝する。